

Characterization and consolidation of thermoelectric CrSi₂ compound prepared by mechanical alloying

Chung-Hyo Lee[†] and Young Kim

Dept. of Advanced Materials Science and Engineering, Mokpo National University, Muan 534-729, Korea

(Received April 29, 2013)

(Revised May 16, 2013)

(Accepted May 24, 2013)

Abstract Mechanical alloying was carried out to produce CrSi₂ thermoelectric compound using a mixture of elemental Cr₃₃Si₆₇ powders. An optimal milling and heat treatment conditions to obtain the single phase of CrSi₂ compound with fine microstructure were investigated by X-ray diffraction and differential scanning calorimetry measurement. CrSi₂ intermetallic compound with a grain size of 70 nm could be obtained by MA of Cr₃₃Si₆₇ powders for 70 hours and subsequently annealed at 650°C. Consolidation of the MA powders was performed in a spark plasma sintering (SPS) machine using graphite dies at 600~1000°C under 60 MPa. The shrinkage of MA samples during SPS consolidation process increased gradually with increasing temperature up to 1000°C and relatively significant at about 600°C. We tend to believe that these behaviors are deeply related to form a CrSi₂ compound during heating process, as can be realized from the DSC measurement. Electrical conductivity and Seebeck coefficient of sintered bodies were measured up to 900°C. Seebeck coefficient and power factor of Cr₃₃Si₆₇ compact prepared by MA and SPS at 1000°C showed the maximum value of 125 μV/K at 400°C and 4.3×10^{-4} W/mK² at 350°C, respectively.

Key words Mechanical alloying, Thermoelectric CrSi₂ compound, Spark plasma sintering (SPS), Nano-sized grain

MA법으로 제조된 CrSi₂ 열전화합물의 평가 및 치밀화

이충호[†], 김영

목포대학교 신소재공학과, 무안, 534-729

(2013년 4월 29일 접수)

(2013년 5월 16일 심사완료)

(2013년 5월 24일 게재확정)

요약 본 연구에서는 CrSi₂ 열전화합물을 제조하기 위하여 순금속 Cr₃₃Si₆₇ 혼합분말을 기계적 합금화 처리하였다. 초미세 CrSi₂계 열전화합물을 얻기 위하여 최적 분말조건 및 열처리 조건을 X선 회절분석과 시차주사 열량분석을 이용하여 조사하였다. 순금속 Cr₃₃Si₆₇ 혼합분말을 70시간까지 분말 처리 후 650°C까지 열처리함으로써 평균 결정립 크기가 70 nm 인 초미세 CrSi₂ 열전화합물을 얻을 수 있었다. MA 분말시료의 벌크화를 위하여 소결온도 600~1000°C, 압력 60 MPa에서 SPS 소결을 실시하였다. SPS 과정에서 MA 분말의 수축은 소결 개시 후 600°C 전후에서 크나 전반적으로 급격하게 발생하지 않으며 1000°C까지 비교적 단조롭게 수축함을 알 수 있었다. 여기서 수축이 600°C 부근에서 큰 이유는 열분석 결과에서도 보여주듯이 CrSi₂ 화합물의 생성과 관련이 있는 것으로 판단된다. SPS 성형체의 전기전도도 및 제벡계수는 900°C까지 측정을 실시하였으며, 그 결과로부터 제벡계수는 400°C에서 125 μV/K 및 파워팩터는 350°C에서 4.3×10^{-4} W/mK²의 최대값을 각각 나타내었다.

1. 서론

최근 화석연료 고갈로 인하여 신재생에너지에 대한 관

심이 높아지면서 열에너지를 전기에너지로 변환시킬 수 있는 열전재료의 개발이 주목되고 있다. 현재 실용화 되고 있는 열전재료는 희귀금속을 포함하고 있어 가격이 비싸고 사용가능 온도도 낮다는 문제점이 지적되고 있다. 이러한 관점에서 볼 때 FeSi₂를 비롯한 금속 실리사이드는 지구상에 구성원소가 풍부하며 리사이클성이 좋아 차세대 열전재료로서 기대되고 있다. 금속 실리사이드 중

[†]Corresponding author

Tel: +82-61-450-2491

Fax: +82-61-450-2490

E-mail: chlee@mokpo.ac.kr

에서 CrSi_2 화합물은 낮은 전기저항 및 비교적 높은 제벡계수가 얻어지며, 특히 고온에서 화학적으로 안정하여 실용 열전재료로서 매우 유망하다고 할 수 있다[1-4].

열전성능지수는 전기전도도, Seebeck 계수, 열전도도에 의하여 결정되며, 전기전도도 및 Seebeck 계수 값이 크고 열전도도가 작을수록 큰 열전성능지수가 얻어진다. 한편 열전재료는 제조법에 따라 큰 특성 차이를 나타내며 분말야금법으로 제조함으로써 기계적 강도 향상은 물론 열전특성의 균일성 및 성능지수를 향상시킬 수 있다. 특히 결정격자의 열전도도는 결정립의 미세화와 결정격자 내 스트레인을 도입시킴으로써 저하시킬 수 있다[5-8].

기계적 합금화(Mechanical Alloying: MA)법은 고상반응법 중 하나로 금속원소를 분말상태 그대로 불밀 처리함으로써 기계적인 충격, 마찰, 압축응력 등을 가하여 합금화하는 방법으로 구조재료는 물론 새로운 기능성 분말 재료를 제조할 수 있는 합금화 공정으로 주목 받고 있다. 따라서 본 연구의 열전재료 합성과 같이 기계적 에너지의 투여에 의해 결정립의 초미세화와 결정격자 내 스트레인을 도입시킴으로써 열전성능지수를 높일 수 있는 최적 분말제조 공정이라고 할 수 있다[9-15].

본 연구에서는 고온 영역에서 사용할 수 있는 CrSi_2 계 열전화합물을 기계적합금화법으로 제조하고, 얻어진 MA 분말시료의 방전플라즈마소결(SPS)을 통하여 벌크화하였다. 단상의 CrSi_2 열전화합물 제조를 위하여 얻어진 MA 분말시료의 승온에 따른 상변화 과정을 자세히 조사하였다. 또한 분말시료의 SPS 소결과정, 구조변화, 미세조직 및 벌크체의 각종 특성을 평가하였다.

2. 실험방법

본 실험에서 출발원료로는 고순도 화학제 $\text{Cr}(99.9\%)$, 평균입경 $60\ \mu\text{m}$ 및 $\text{Si}(99.999\%)$, 평균입경 $150\ \mu\text{m}$ 분말을 사용하였으며 출발조성은 각 원료분말을 CrSi_2 화합물의 화학양론 조성인 $\text{Cr}_{33}\text{Si}_{67}$ 으로 혼합한 후 MA를 실시하였다. 기계적합금화는 유성형 불밀장치(Fritsch P-5)를 사용하였으며 불밀용기에 원료분말을 장입하여 2회 정도 진공배기한 후 고순도 아르곤 가스(99.999%) 분위기에서 실시하였다. 용기는 자체 제작한 소입 다이스강(SKD11)제로 내용적은 $80\ \text{cc}$ 이었으며 불은 직경 $10\ \text{mm}$ 의 SUS304제를 사용하였다. 유성형 불밀장치의 회전속도는 $200\ \text{rpm}$ 으로 실시하였으며 30분 운전 후 6분 정지를 반복하는 모드를 통하여 연속운전 시 발생할 수 있는 온도상승을 억제하였다.

얻어진 MA 분말시료는 불활성 가스로 치환된 글로브 박스 내에서 처리된 후 생성상을 동정하기 위하여 X선 회절($\text{Cu-K}\alpha$)분석을 행하였다. 열분석은 DSC(승온속도

$20^\circ\text{C}/\text{min}$)에 의해 최고 650°C 까지 행하였다. 또한 분말의 미세조직 및 조성분석은 각각 주사전자현미경(SEM) 및 EPMA를 사용하였다. 제조된 MA 합금분말에 대하여 나노결정 및 초미세 합금분말의 생성여부를 X선 회절피크의 broadening으로부터 Hall 법에 의하여 평가하였다[16].

기계적합금화법으로 제조된 분말시료의 벌크화를 위하여 방전플라즈마 소결장치를 이용하여 단시간 소결을 실시하였다. 소결은 진공 중에서 소결압력 $60\ \text{MPa}$, 승온속도 $100^\circ\text{C}/\text{min}$ 로 $600\sim 1000^\circ\text{C}$ 까지 승온시킨 후 3분 유지하였다. SPS법으로 소결된 시료를 이용하여 전기전도도(electrical conductivity), 제벡계수(Seebeck coefficient)를 측정하고 그 값을 이용하여 파워팩터(power factor) 값을 평가하였다.

3. 실험결과 및 고찰

Fig. 1은 Cr-Si 계의 평형상태도를 나타내었다. 그림에서 보여주듯이 이 합금계에는 Cr_3Si , Cr_5Si_3 , CrSi 및 CrSi_2 금속간화합물이 존재하며 이 중에서 congruent melting 조성인 CrSi_2 는 반도체 열전화합물로 알려져 있다[17, 18].

Fig. 2은 $\text{Cr}_{33}\text{Si}_{67}$ 혼합분말의 MA 시간 변화에 따른 X선 회절패턴을 나타낸 것이다. MA 처리는 100시간까지 실시하였으며 출발시료, MA 0시간은 회절선의 강도를 1/2배로 나타내었다. 그림에서 볼 수 있듯이 MA 처리를 20시간까지 행하면 결정립의 미세화 및 불균일 변형의 축적에 의하여 회절선 피크는 폭이 넓어지고(broadening) 회절선 강도는 보다 취성원소인 Si 회절선이 상대적으로 현저하게 감소함을 알 수 있다. MA 처리를 50시간까지 실시하면 CrSi_2 화합물의 회절피크가 뚜렷하게 관찰되나

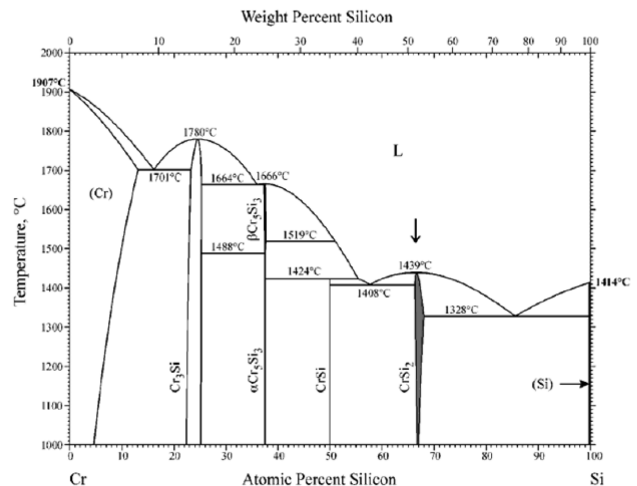


Fig. 1. Phase diagram of equilibrium Cr-Si alloy system.

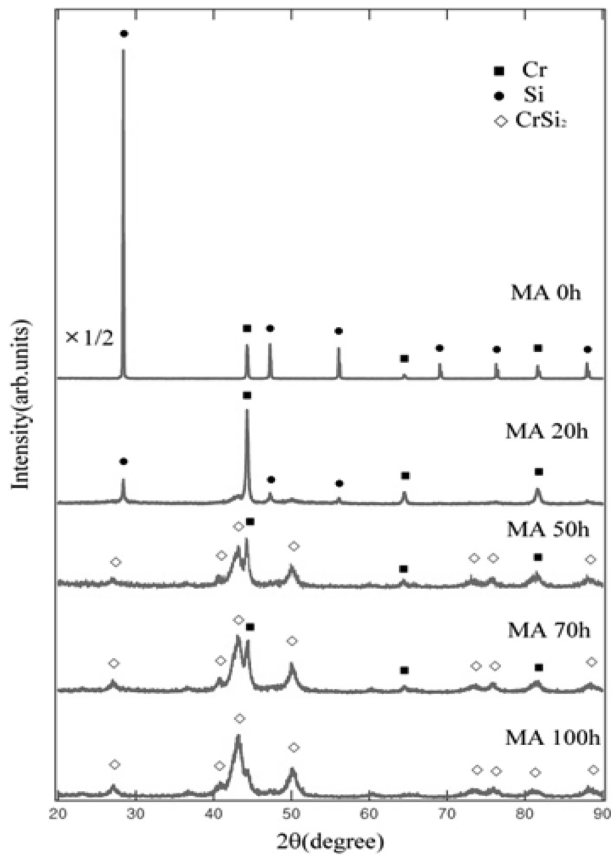


Fig. 2. X-ray diffraction patterns of Cr₃₃Si₆₇ powders as a function of MA time.

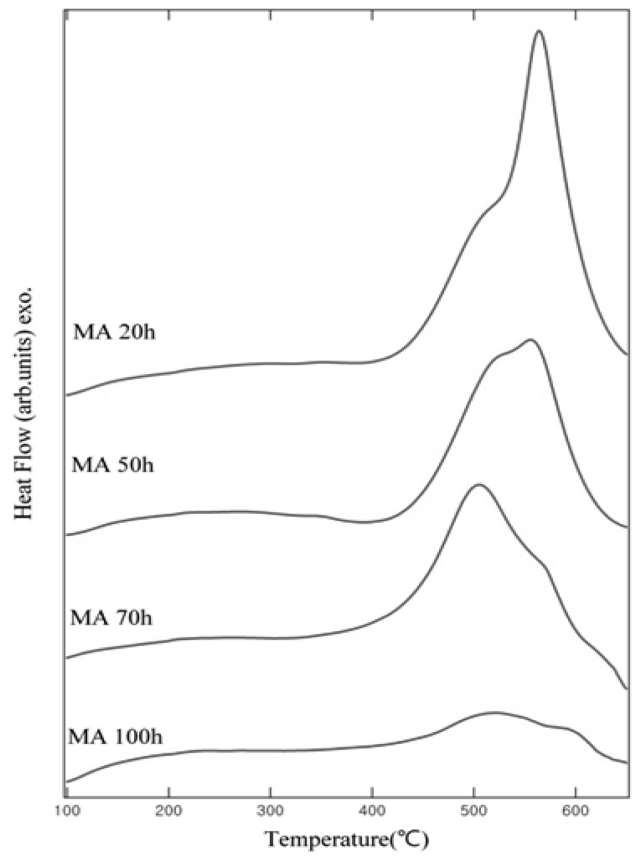


Fig. 4. DSC spectra of Cr₃₃Si₆₇ powders as a function of MA time.

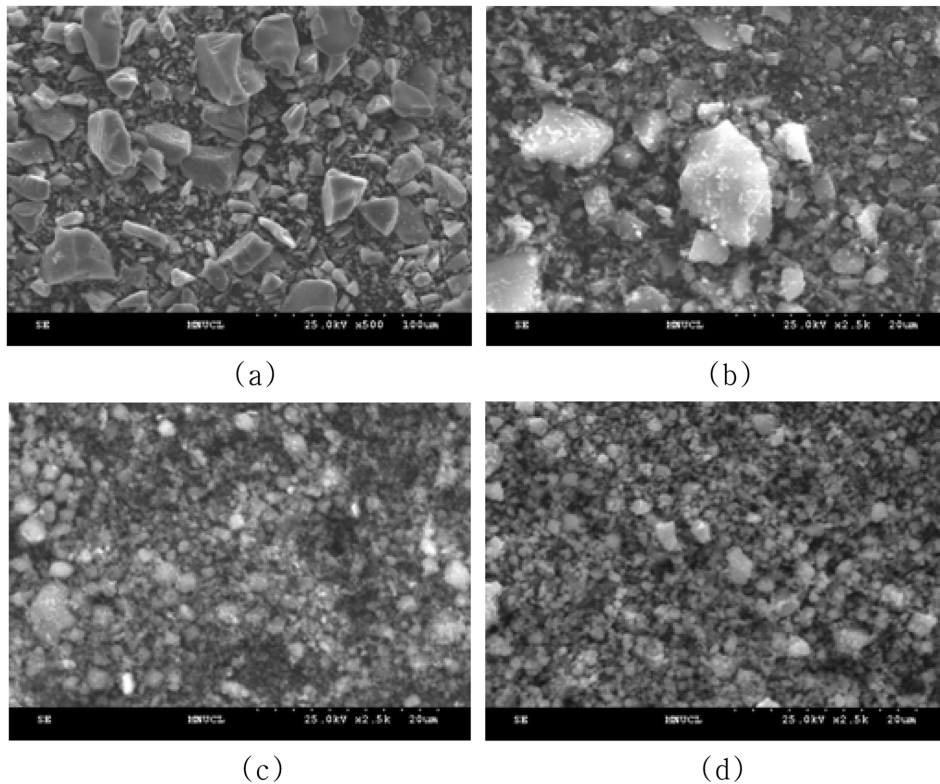


Fig. 3. Scanning electron micrographs of Cr₃₃Si₆₇ powders mechanically alloyed for (a) 0 h, (b) 30 min, (c) 50 h and (d) 100 h.

여전히 출발시료 Cr이 잔존하여 고상반응이 진행 중임을 알 수 있다. 여기서 MA 처리를 100시간까지 행하면 CrSi_2 화합물의 생성에 의한 회절선만이 관찰된다. 또한 CrSi_2 화합물 회절선의 폭이 넓어진 점으로부터 MA공정에 의하여 초미세 결정립의 열전분말재료가 생성된 것으로 판단된다.

Fig. 3은 $\text{Cr}_{33}\text{Si}_{67}$ 혼합분말의 MA 처리에 따른 형상변화를 알아보기 위하여 SEM 관찰 결과를 나타낸 것이다. 그림에서 보여주듯이 MA 0시간에는 순 Cr 및 순 Si의 물리적인 혼합상태로, 입자가 크고 입자크기에 분포가 있는 것이 순 Si 분말임을 특성 X 선 분석을 통하여 알 수 있었다(Fig. 3a). 여기서 MA 처리를 30분까지 실시하면 냉간 압접에 의해 불규칙한 형상의 분말이 얻어지며(Fig. 3b), 여기서 MA를 50, 100시간까지 계속 실시하면 그림에서 보여주듯이 입자가 점차 미세해지며 평균 입경 $0.5 \mu\text{m}$ 정도의 매우 미세하고 균일한 합금분말이 얻어짐을 알 수 있다.

Fig. 4는 MA에 의하여 얻어진 $\text{Cr}_{33}\text{Si}_{67}$ 조성 합금분말의 상분석 및 열처리 조건을 알아보기 위하여 열분석을 행한 결과를 나타내었다. 그림에서 알 수 있는 바와 같이 20, 50 및 70시간 MA 처리한 시료의 DSC 측정

서는 550°C 부근에 비교적 큰 발열반응이 관찰되었다. 한편 100시간 MA 처리한 시료에서는 broad 하고 작은 발열반응만이 관찰되어 MA 처리에 의하여 고상반응이 거의 완료된 것임을 알 수 있다.

MA 처리에 의하여 얻어진 Fig. 2의 분말시료에 대하여 열분석 후 발열반응에 의한 상변화를 X선 회절법으로 조사하였으며, 그 결과를 Fig. 5에 나타내었다. 그림에서 알 수 있는 바와 같이 MA 처리 50시간 후 열분석을 실시한 경우 CrSi_2 화합물과 함께 출발상인 Cr 및 Si가 잔존함을 알 수 있다. 한편 MA 처리를 70시간 이상 처리하면 650°C 까지의 승온에 의하여 CrSi_2 화합물 단상이 생성됨을 알 수 있다. 이상의 결과로부터 CrSi_2 화합물의 합성을 위해서는 $\text{Cr}_{33}\text{Si}_{67}$ 혼합분말을 실온에서 100시간 이상 MA 처리하거나 또는 70시간 MA 처리 후 650°C 까지의 열처리가 필요함을 알 수 있었다.

Fig. 6에는 70시간 MA 처리한 분말시료에 대하여 200°C , 400°C , 650°C 까지 각각 승온시킨 후 X선 회절법에 의한 구조변화를 나타내었다. 그림에서 보여주듯이 400°C 까지의 승온에 의하여 CrSi_2 화합물, Cr 이외에 새로운 상은 나타나지 않고 결정립 성장 및 결정결함의 완화에 의한 회절선 폭의 감소가 관찰되었다. 한편 650°C

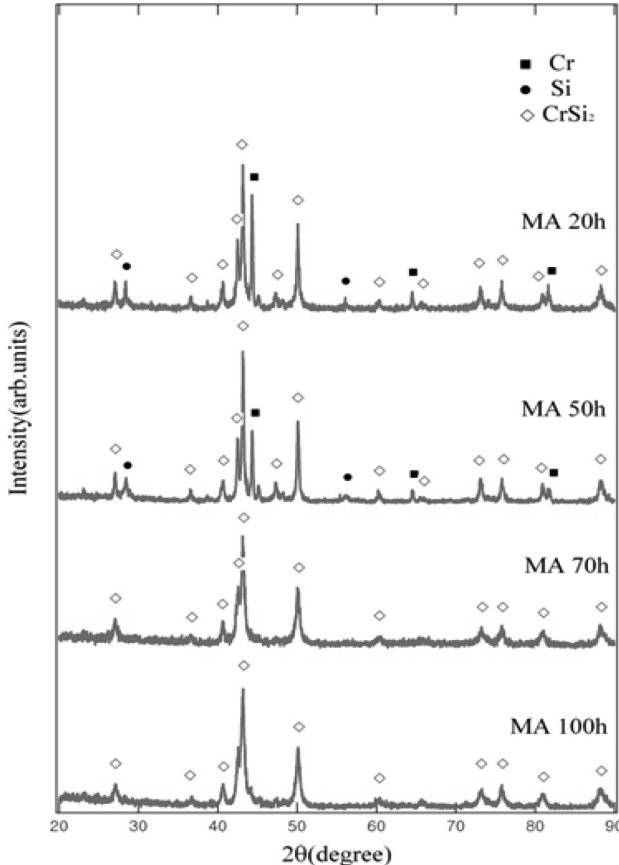


Fig. 5. X-ray diffraction patterns of $\text{Cr}_{33}\text{Si}_{67}$ MA powders after DSC measurement.

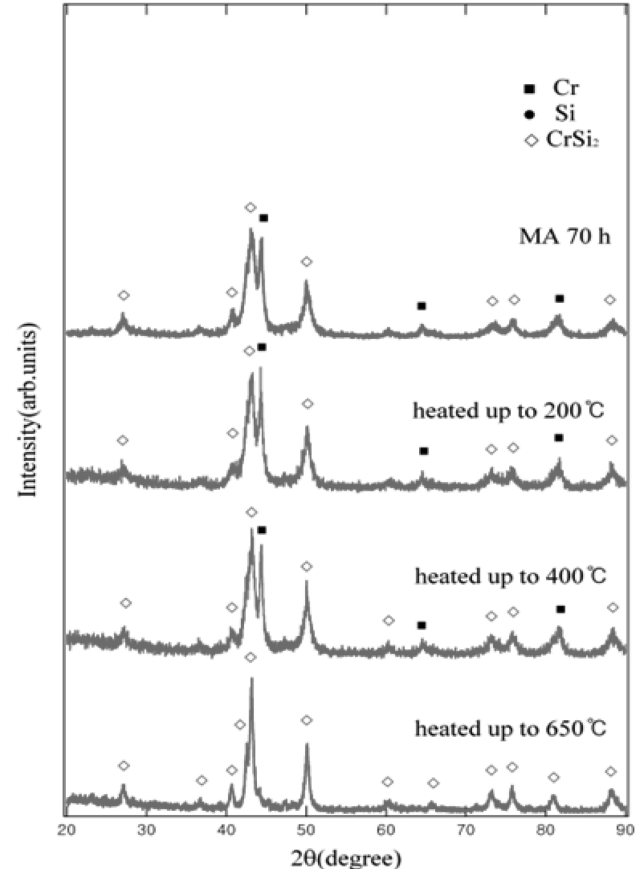


Fig. 6. X-ray diffraction patterns of 70 h MA powders heated up to 200°C , 400°C and 650°C , respectively.

까지 승온시킨 경우 큰 발열반응이 발생하는데 이것은 X선 회절패턴으로부터 잔존하는 출발상이 모두 CrSi₂ 화합물로의 상변화에 의한 것임을 알 수 있다.

여기서 MA 및 열처리에 의하여 생성된 CrSi₂ 열전화합물의 평균결정립 크기를 구하기 위하여 X선 회절 피크의 반가폭을 이용하여 Hall 법으로 계산하였다[16]. Hall 식 $\beta \cos\theta/\lambda = (2\eta \sin\theta/\lambda) + 1/\epsilon(\beta)$: 회절선 반가폭, η : 격자 스트레인) 에서는 plot의 절편으로부터 평균 결정립 크기(ϵ)를 구할 수 있다. 여기서 시료에 의한 정확한 반가폭을 측정하기 위하여, 표준시료 α -SiO₂를 사용하여 광학계 보정을 실시한 후 step scanning법으로 적분 반가폭을 구하여 적용하였다. 그 결과 MA 처리 70시간 후 650°C까지 열처리법으로 생성된 CrSi₂ 화합물의 평균결정립 크기는 70 nm로 매우 미세한 열전화합물이 얻어졌음을 알 수 있었다.

Fig. 7는 MA 분말시료의 소결거동을 알아보기 위하여 70시간 MA를 행한 Cr₃₃Si₆₇ 혼합분말에 대하여 SPS 소결 시 800°C, 900°C, 1000°C까지 각각 승온시킨 후 시료의 수축곡선을 나타내었다. 그림에서 보여주듯이 SPS

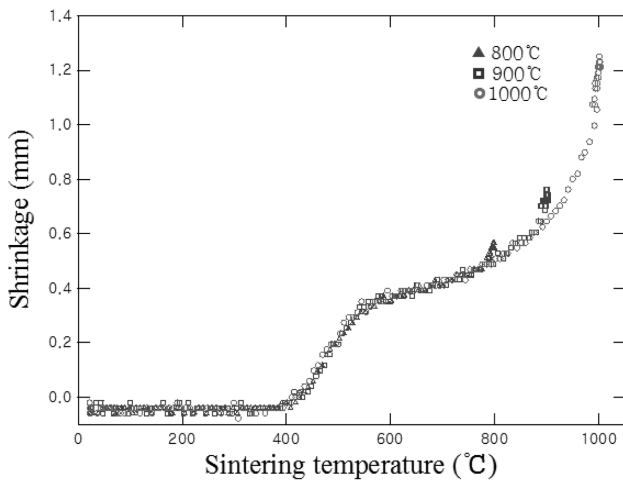


Fig. 7. The variation of shrinkage during SPS of 70 h MA sample heated up to 800°C, 900°C and 1000°C, respectively.

과정에서 MA 분말의 수축은 소결 개시 후 600°C 전후에서 크나 전반적으로 급격하게 발생하지 않으며 1000°C까지 비교적 단조롭게 수축함을 알 수 있다. 여기서 수축이 큰 600°C 구간은 Fig. 2의 열분석 결과에서도 보여주듯이 CrSi₂ 화합물의 생성에 의한 발열반응과 관련이 있는 것으로 판단된다.

Fig. 8에는 MA 70시간 시료를 600°C, 800°C, 1000°C까지 SPS 소결하였을 때 벌크시료의 X선 회절패턴을 나타낸 것이다. 그림에서 볼 수 있는 바와 같이 모든 소

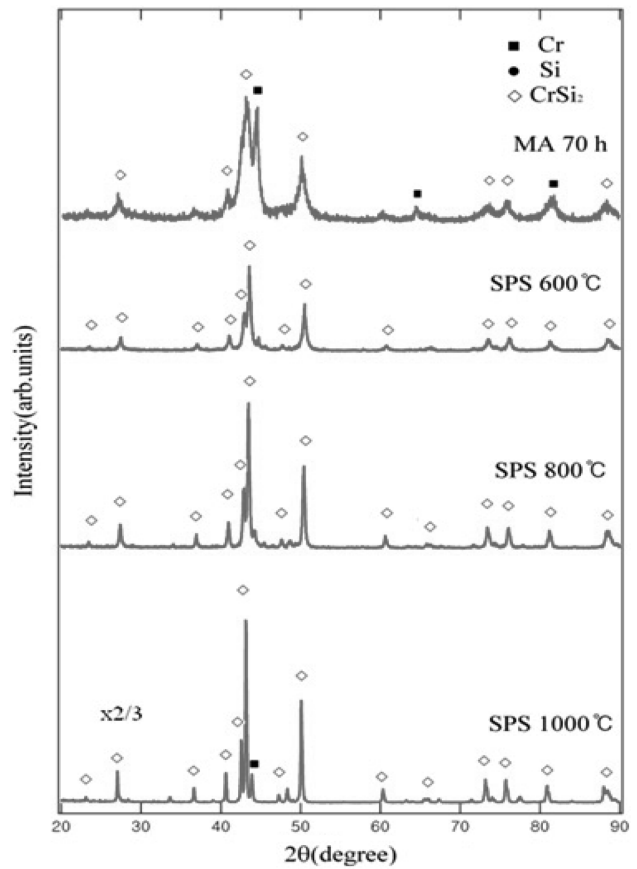


Fig. 8. X-ray diffraction patterns for SPS sintered body of Cr₃₃Si₆₇ powders mechanically alloyed for 70 h.

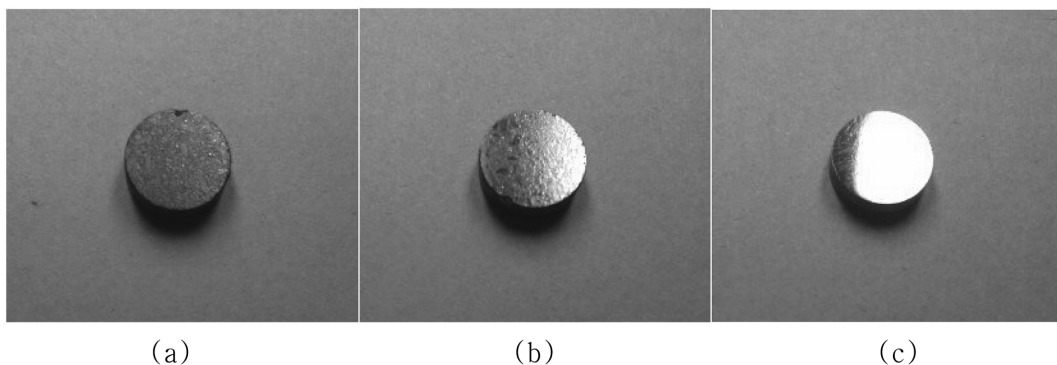
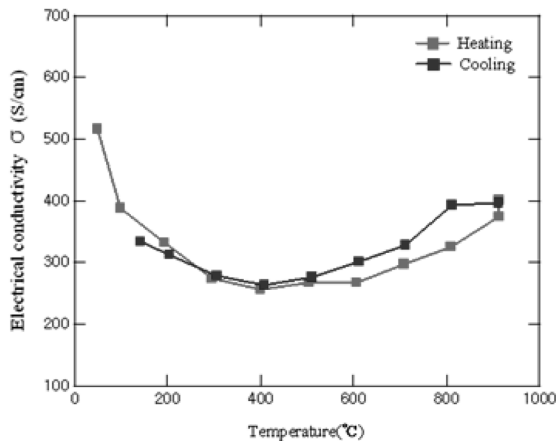


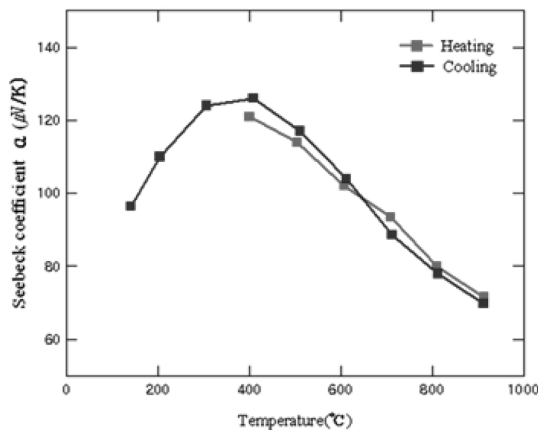
Fig. 9. Photographs of SPS compacts sintered at (a) 600°C, (b) 800°C and (c) 1000°C.

Table 1
Sintering temperature dependence of relative density for SPS compacts

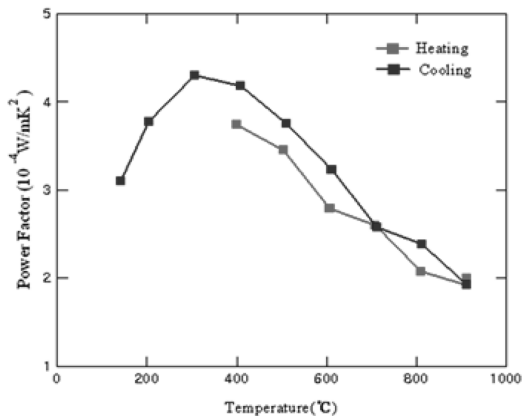
| Sintering temp. | Theory density | Relative density |
|-----------------|----------------|------------------|
| 600°C | 4.98 | 64.7 % |
| 800°C | 4.98 | 72.7 % |
| 1000°C | 4.98 | 94.6 % |



(a)



(b)



(c)

Fig. 10. Temperature dependence of (a) electrical conductivity, (b) Seebeck coefficient, and (c) power factor for SPS compacts sintered at 1000°C.

결온도에서 잔존하는 Cr상이 소결 시 반응하여 단상의 CrSi_2 화합물이 얻어짐을 알 수 있다. 또한 Hall 법으로 계산된 소결온도 800°C 및 1000°C 소결체의 평균 결정립 크기는 각각 100 nm 및 300 nm이었다.

Fig. 9 및 Table 1에는 SPS법으로 소결시킨 Fig. 8 시료에 대하여 벌크체 외관 및 상대밀도를 나타내었다. 소결온도가 비교적 낮은 600°C 및 800°C 시료의 경우 표면이 매우 거칠었으며 상대밀도도 각각 64.7% 및 72.7%로 낮은 값을 보였다. 한편 소결온도 1000°C의 경우 금속 고유의 광택을 나타내며 상대밀도 값은 94.6%로 매우 치밀한 성형체임을 알 수 있었다. 이것은 SPS 소결 시 단상의 CrSi_2 화합물 벌크체를 얻기 위해서는 600°C 이상의 소결온도로 충분하나, 이 경우 낮은 상대밀도 값이 관찰되며 치밀한 소결체를 얻기 위해서는 1000°C 이상의 소결온도가 필요함을 알 수 있었다.

MA 처리를 70시간 실시한 후 1000°C에서 SPS 소결시킨 성형체의 전기전도도, 제벡계수 및 파워팩터 값을 Fig. 10에 각각 나타내었다. 그림에서 전기전도도 및 제벡계수는 승온 및 냉각 시 2회 측정을 행하여 나타내었다. 그림에서 알 수 있는 바와 같이 CrSi_2 성형체의 전기전도도는 400°C에서 최소값을 보인 후 그 이상의 온도에서는 진성반도체와 같은 거동을 보였다. 또한 전 온도영역에서 다른 실리콘화물 열전재료에 비하여 높은 전기전도도가 얻어짐을 알 수 있다[7]. 또한 그림에서 보여 주듯이 제벡계수는 400°C에서 최대값, 125 $\mu\text{V}/\text{K}$ 을 보인 후 그 이상의 온도에서는 온도 증가에 따라 감소함을 알 수 있었다. 여기서 CrSi_2 성형체의 전기전도도 및 제벡계수로부터 얻어진 파워팩터(power factor)를 Fig. 9(c)에 나타내었다. 그림에서 알 수 있는 바와 같이 350°C에서 최대값, $4.3 \times 10^{-4} \text{ W}/\text{mK}^2$ 를 보인 후 감소하였다. 현재 MA 법 및 SPS 소결법으로 제조된 CrSi_2 열전화합물의 열전도도 평가실험을 진행 중에 있다.

4. 결 론

본 연구에서는 $\text{Cr}_{33}\text{Si}_{67}$ 혼합분말의 기계적합금화 처리 및 방전플라즈마 소결을 통하여 CrSi_2 열전화합물의 상생성 과정을 조사하여 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.

- 1) CrSi_2 열전화합물 제조를 위하여 $\text{Cr}_{33}\text{Si}_{67}$ 혼합분말을 100시간까지 MA 처리한 결과 50시간 이후부터 고상반응에 의한 화합물 생성이 관찰되었다.
- 2) $\text{Cr}_{33}\text{Si}_{67}$ 혼합분말을 70시간 동안 MA 처리 후 650°C까지 열처리함으로써 평균 결정립 크기가 70 nm인 매우 미세한 단상의 CrSi_2 열전 합금분말을 제조할 수 있었다.
- 3) 70시간 동안 MA 처리한 분말시료를 1000°C까지 SPS 소결을 실시한 결과, 상대밀도 94.6%, 금속 고유의

의 광택을 가진 치밀한 소결체를 제조할 수 있었다.

4) 1000°C에서 소결된 SPS 벌크체의 제벡계수는 400°C에서 125 μV/K 및 파워팩터는 350°C에서 4.3×10^{-4} W/mK²의 최대값을 각각 보였다.

본 연구에서 얻어진 소결체의 제벡계수 및 파워팩터 특성으로부터 MA 법으로 제조된 나노결정립 CrSi₂ 화합물의 열전 성능지수는 높은 값이 예상되며, 이 소재는 고온용 열전재료로서 그 응용이 기대된다.

참 고 문 헌

- [1] R. Yazdani-rad, S.A. Mirvakili and M. Zakeri, "Synthesis of (Mo_{1-x}Cr_x)Si₂ nanostructured powders via mechanical alloying and following heat treatment", *J. Alloy and Compounds* 489 (2010) 379.
- [2] D.M. Rowe and C.M. Bhandari, "Modern thermoelectrics", Rinehart and Winston, London (1988).
- [3] H. Lange, "Electron properties of semiconducting silicides", *Phys. Stat. Sol.* 201 (1997) 3.
- [4] Y. Isoda, Y. Imai and Y. Shinohara, "The effect of crystal grain size on thermoelectric properties of sintered β-FeSi₂", *J. Jpn. Inst. Metals* 67 (2003) 410.
- [5] M. Zakeri, R. Yazdani-Rad, M.H. Enayati, M.R. Rahimpour, "Synthesis of nanocrystalline MoSi₂ by mechanical alloying", *J. Alloy and Compounds* 403 (2005) 258.
- [6] L.F. Mattheiss, "Calculated structural properties of CrSi₂, MoSi₂, and WSi₂", *Phys. Rev. B: Condens. Matter* 45 (1992) 3252.
- [7] M. Umemoto, Z.G. Liu, R. Omatsuzawa and K. Tsuchiya, "Production and characterization of Mn-Si thermoelectric material", *J. Metastable and Nanocrystalline Materials* 8 (2000) 918.
- [8] I.K. Kim, "Synthesis of thermoelectric Mg₃Sb₂ by melting and mechanical alloying", *Journal of Korean Crystal Growth and Crystal Technology* 22 (2012) 207.
- [9] C.H. Lee, "Fabrication and characterization of Mn-Si thermoelectric materials by mechanical alloying", *Journal of Korean Crystal Growth and Crystal Technology* 21 (2011) 246.
- [10] U. Mizutani and C.H. Lee, "Effect of mechanical alloying beyond the completion of glass formation for Ni-Zr alloy powders", *J. Mat. Sci.* 25 (1990) 399.
- [11] H.J. Fecht, E. Hellstern, Z. Fu and W.L. Johnson, "Nanocrystalline metals prepared by high-energy ball milling", *Metal. Trans.* 21 (1990) 2333.
- [12] J. Eckert and L. Schultz, "Glass formation and extended solubilities in mechanically alloyed cobalt-transition metal alloys", *J. Less-Common Metals* 166 (1990) 293.
- [13] C.H. Lee, "Fabrication and structural observation of amorphous V-Co alloy by mechanical alloying", *Journal of Korean Crystal Growth and Crystal Technology* 22 (2012) 51.
- [14] C.H. Lee, M. Mori and U. Mizutani, "Differential scanning calorimetry study of various intermetallic compounds subjected to mechanical grinding", *J. Non-Cryst. Solids* 117-118 (1990) 733.
- [15] C.H. Lee, M. Mori, T. Fukunaga and U. Mizutani, "Structural evidence for the amorphization of mechanically alloyed Cu-Ta powders studied by neutron diffraction and EXAFS", *Mat. Sci. Forum* 88-90 (1992) 399.
- [16] W.H. Hall, "Characterization of crystal size and strain by X-ray diffraction", *J. Inst. Met.* 75 (1948) 1127.
- [17] T.B. Massalski, "Binary alloy phase diagrams", 2nd ed. (ASM, 1990).
- [18] F.R. de Boer, R. Boom, W.C.M. Matten, A.R. Miedema and A.K. Niessen, "Cohesion in metals" (North-Holland, Amsterdam, 1988).